

Dk 3.08 Df 0.0012 @14GHz

Tg (DMA) 220°C

T288(含铜) >120分钟

MEGTRON8S MEGTRON8

芯板
R-579YS(U)/(N)

半固化片
R-569YS(U)/(N)

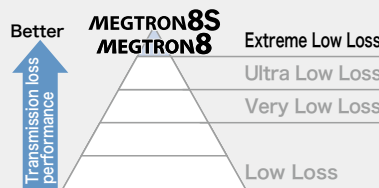
(U): 超低介质损耗因数玻璃布类型
(N): 低介电常数玻璃布类型

芯板
R-579Y(U)/(N)

半固化片
R-569Y(U)/(N)

超低传输损耗·高耐热性多层基板材料

支持下一代高速通信技术 800GbE。MEGTRON8 R-579Y(U) 与 MEGTRON7 R-578Y(N) 相比, 传输损耗提高了约 30%(在 28GHz)、有助于提高高速通信网络设备的性能。

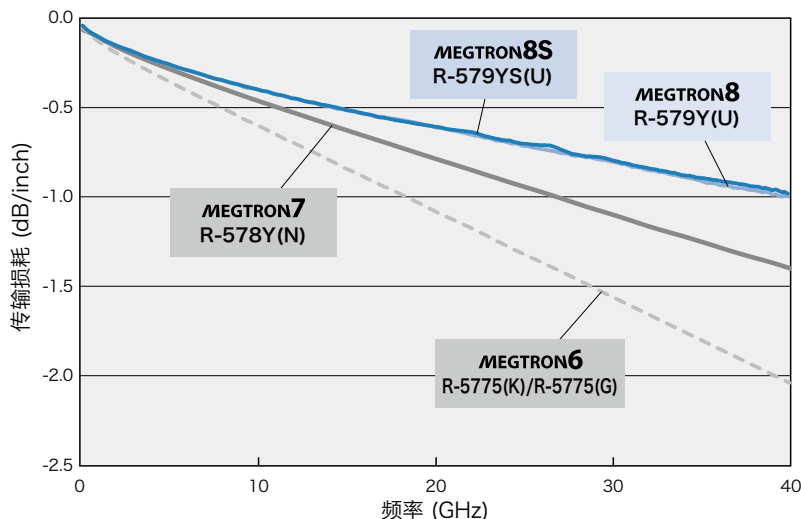


应用 网络/无线通信

路由器、交换机、光传输设备、服务器、AI服务器、基站、半导体试验设备、探针卡等

传输损耗比较

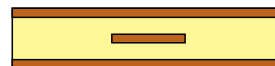
MEGTRON8 R-579Y(U) 与 MEGTRON7 R-578Y(N) 相比, 改善约 30%*



* 28GHz时的传输损耗改善效果

$$\frac{\text{传输损耗差 (MEGTRON7 - MEGTRON8)}}{\text{传输损耗 (MEGTRON7)}} \times 100 \approx 30\%$$

评价样本(截面图)



PCB构成	3层PCB 带状线
铜箔厚度	18 μm(内层)
覆铜板材料 CCL	0.13mm
树脂固化片 PP	0.15mm
特性阻抗	50Ω
内层表面处理	无表面处理
测量方法	2端口 S参数
测量频率	0.2-40 GHz
校正方法	多线TRL法

上述数据为本公司测量值, 非保证值。

一般特性

项目	试验方法	条件	单位	MEGTRON8S R-579YS(U) 超低介质损耗因数玻璃布	MEGTRON8S R-579YS(N) 低介电常数玻璃布	MEGTRON8 R-579Y(U) 超低介质损耗因数玻璃布	MEGTRON8 R-579Y(N) 低介电常数玻璃布
玻璃态转化温度(Tg)	DMA	A	°C	220	220	220	220
热膨胀系数 (Z-轴方向)	α1	IPC-TM-650 2.4.24	A	ppm/°C	35	35	50
					α2	240	240
T288(含铜)	IPC-TM-650 2.4.24.1	A	分钟	>120	>120	>120	>120
介电常数(Dk)	14GHz 平衡型圆盘共振法	C-24/23/50	-	3.19	3.22	3.08	3.13
介质损耗因数(Df)				0.0012	0.0015	0.0012	0.0016
铜箔剥离强度	1oz(35μm) IPC-TM-650 2.4.8	A	kN/m	0.7 [H-VLP3]	0.7 [H-VLP3]	0.7 [H-VLP3]	0.7 [H-VLP3]

试验片厚度为0.75mm。

在使用本产品时, 请在我公司网站上确认注意事项。

上述数据为本公司测量所得的代表值, 非保证值。

industrial.panasonic.com/ea/electronic-materials

松下电器机电 MEGTRON8S MEGTRON8

松下电器机电(中国)有限公司

© Panasonic Industry (China) Co., Ltd. 202503